

Transistor NPN TIP102

Codigo: **111908**



Descripción

Transistor TIP102, epitaxial de silicio 100V con polaridad NPN y darlington diseñado para su uso en aplicaciones de amplificación de potencia y conmutación. Cuenta con construcción monolítica con resistencias en derivación base-emisor.

- Alta ganancia de corriente continua ($h_{FE} = 1000$ a $V_{CE} = 4V$, $I_C = 3A$ mínimo)
- 100V Voltaje del colector (VCBO)
- Darlington
- Baja tensión de saturación colector-emisor
- 5V Voltaje de la base del emisor (VEBO)
- 1A Corriente base (IB)
- Complemento: TIP105/106/107

Aplicaciones: Amplificador de potencia, conmutación, uso general

- Polaridad del transistor: NPN
- Voltaje colector base VCBO: 100 V
- Voltaje colector emisor VCEO: 100 V
- Voltaje emisor base VEBO: 5 V
- Corriente colector DC I_C : 8 A
- Disipación de potencia P_C ($T_C = 25^\circ C$): 80 W
- Ganancia de corriente continua h_{FE} : 200 h_{FE}
- Temperatura de operación mínima: $-65^\circ C$
- Temperatura de operación máxima: $150^\circ C$
- Encapsulado: TO-220
- 3 pines

Sustituto

- NTE2343